2.7. Фасетирование поверхности

Не только релаксация и реконструкция

Причина

Изменение кристаллографической ориентации на отдельных участках

Поверхностная энергия

Зависит от кристаллографической ориентации, выше у более рыхлых граней

Проволоки, имеющие правильную цилиндрическую форму, после прогрева перекристаллизуются так, чтобы на поверхность были плотноупакованные грани

Проигрыш в энергии за счет увеличения площади поверхности



Выигрыш вследствие различия удельных поверхностных энергий.

Итог – появление участков с различной кристаллографической ориентацией.



Фасетирование поверхности.

Наблюдается на монокристаллических поверхностях

Ge(110):



при повышенных температурах на поверхности фасетки из других граней (микроогранка)

"Благополучная" грань (011) золота

Расположение рефлексов на дифракционной картине соответствует структуре (2x1).

Взъерошивание, гофрировка, модель пропущенных рядов

Вычисления, привели к противоречивым результатам

• Эксперименты по рассеянию ионов гелия показали, что она обладает значительно большей шероховатостью, чем предсказывается моделью пропущенных рядов

• Необходимы значительно большие времена для перехода от структуры (1x1) к структуре (2x1), чем это наблюдается на эксперименте

Для реконструкции атомы должны мигрировать на несколько сот ангстрем (от 200 до 2000 Å)

У (2x1) шероховатость 0,45 Å, в случае структуры (3x1) - 1,4 Å.



Сканирующая туннельная микроскопия

Ленточная структура

Au (011)

Холмы вдоль [110] на сотни Å, разделены на расстояние ~8 Å, т.е. структура (2x1).

Часто ленты отделяются друг от друга ступенями и каналами, что ~ (*3x1*) и даже (*4x1*).



на самом деле набор ленточных фасеток грани (111) шириной, равной 2-3 атомным рядам,

На стенках каналов - структура грани (111)

Объясняет наблюдаемую по рассеянию ионов повышенную шероховатость.

У (2x1) шероховатость 0,45 Å, в случае структуры (3x1) - 1,4 Å. Si(100) - наряду с (2x1) имеются места с *p*(2x1) и *c*(2x1)

Часто поверхность не равновесна

Ступенчатые грани *Pt*, образованных срезом под углом к граням (111) или (001)

По расчетам

Минимальную *γ* имеют только плоскости с низкими индексами.

Грани, соответствующие другим направлениям, в том числе ступенчатые, не стабильны,

По ДМЭ - у *Pt* ступенчатые грани не исчезают даже при отжиге выше 700 К

Устойчивость объясняется затрудненностью путей перестройки

- Механизмы:
- поверхностная диффузия
 - термическая десорбция
 - объемная диффузия

Требуется значительная энергия, необходимо большое время

Зачастую имеют дело с поверхностями не достигшими равновесного состояния

Фасетирование может стимулироваться адсорбцией

(111) W или Mo + моноатомная пленка *Rh, Pd, Ir, Pt, Au, O* или *Cl.*



Пирамиды с огранкой гранями {211}



W(111), на которую нанесена моноатомная пленка Pd, после отжига при 1075 К

Почему не гранями {110}, имеющими наименьшую поверхностную энергию

Фасетирование гранями {211} увеличивает площадь на 6%

При огранке {110} площадь должна возрасти на 22%.

Фасетирование не происходит при адсорбции *CO, Ti, Gd, Ni, Cu, Ag.*

_____>

Важна электронная структуры.

Фасетируют адсорбаты с электроотрицательностью >2,0

Не фасетируют адсорбаты с электроотрицательностью <2,0

Аналогично на поверхности Ge(103) при адсорбции сурьмы

После кратковременного (*5 мин*) отжига при *800 К* поверхность разбивается на пирамиды высотой ~10 Å и шириной ~80 Å с ориентацией граней {113}. Более длительный отжиг (*20 мин*) приводит к объединению пирамид в ленты зубчатой формы длиной *2000 Å.* Их ширина ~ *170 Å*, а высота –*20 Å*.

В некоторых случаях микроогранка может быть не стабильной и иметь место только при повышенных температурах.